CLIPPEDIMAGE= JP362042514A

PAT-NO: JP362042514A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 62042514 A

TITLE: MOLECULAR BEAM CRYSTAL GROWTH DEVICE

PUBN-DATE: February 24, 1987

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

KONDO, KAZUHIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

FUJITSU LTD

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP60182270

APPL-DATE: August 20, 1985

INT-CL (IPC): H01L021/203; H01L021/26

US-CL-CURRENT: 118/713

ABSTRACT:

PURPOSE: To prevent attenuation of light preventing a view port from becoming

cloudy, by providing the device with a construction where light coming from the

view point is applied to a substrate through a small hole in a shielding plate which is placed at the focal point.

CONSTITUTION: A shielding plate 15 is, for example, made of tantalum and

provided with a hole 15a with a diameter of 1mm, and a hole 15a is positioned

on the focal point of a lens 12. The plate 15 is arranged a little bit distant

from the wall of a chamber 19, and the flow of molecules produced by

reevaporation of a substrate 16 is prevented from entering the furnace while

the inside of the port 14 is held about the same vacuum degree as that of the

chamber. The light is stopped down through the hole 15a and applied to the

substrate 16, however, the molecules produced by the reevaporation of the

substrate 16 scarcely reach the view port 13 since the hole is small, with the

result that the view port 13 does not become cloudy, thereby

11/08/2001, EAST Version: 1.02.0008

preventing the the light form being attenuated.

COPYRIGHT: (C) 1987, JPO&Japio

⑨ 日本 国特許 庁(JP) ⑪ 特許 出願 公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62 - 42514

(si)Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和62年(1987)2月24日

H 01 L 21/203 21/26

7739-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

49発明の名称

分子線結晶成長装置

②特 願 昭60-182270

願 昭60(1985)8月20日 23出

79発 明 者 近 藤 和博

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

富士通株式会社 ⑪出 願 人

川崎市中原区上小田中1015番地

②代 理 人 弁理士 井桁 貞一

1. 発明の名称

分子線結晶成長装置

2. 特許請求の範囲

チャンパ (19) に連結されたファーネスのチャ ンバ内の基板 (16) とは反対側に光透過窓 (13) を設け、

前記窓 (13) の外方には光 (11) を絞るレンズ (12) を配置し、

チャンバ (19) のポート (14) に近い部分には 穴(15a) が形成された遮蔽板 (15) を配置し、

前記穴(15a)の位置はレンズ(12)の焦点位 置に合致せしめ、

光 (11) をレンズ (12) 、窓 (13) 、穴 (15a) を通して基板(16)に照射する構成としたことを 特徴とする分子線結晶成長装置。

3.発明の詳細な説明

ピューポート(光の透過窓)と基板の間に焦点 を結ぶような光学系をもち、ピューポートから入 った光が焦点位置におかれた遮蔽板の小穴を通り 基板に照射する構成とした分子線結晶成長装置で ある.

(産業上の利用分野)

本発明は光を用いる分子線エピクキシャル(MBE) 成長に関するもので、さらに詳しく言えば ビューポートのくもりを抑え光の減衰を防ぐ構成 とした分子線結晶成長装置に関する。

〔従来の技術〕

光(例えば紫外光)を基板に照射し、光化学反 応で結晶成長や不純物拡散(ドーピング)を促進 するMBE 法の研究が最近活発になってきた。第3 図には光を利用するガスソース MBE 装置が模式的 に断面図で示されるが、高真空に保たれるチャン パ31にはヒータ33によって加熱される基板32が配 置され、チャンバ31にはポート34が連結され、ポ ート内にはガス導入管35、36を通して成長用ガス と H2 ガスがそれぞれ供給され、基板とは反対側

にはビューボート37が設けられ、光源38から出る 光はレンズ39、ビューボート38を通って基板32上 に照射される。成長用ガスは光を吸収し、光分解 を起して例えば結晶が基板上に堆積される。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明はこのような点に鑑みて創作されたもので、MBB装置において、ピューポートのくもりを

本発明の一実施例は第1図の断面図に示され、図において、11は図示しない光源例えば重水素ランプから出される光、12はレンズ、13はビューポート(光透過窓)、14はポート、15は遮蔽板、15aは遮板板15に形成した小さな穴、16は基板、17は基板が観置されるステージ、18は基板16を例えば600 で~700 でに加熱するヒータ、19は真空チャンパである。真空チャンパは例えば始めに1×10-10 Torr程度の高真空に保たれ、次いで成長用ガスが導入されるときには1×10-6 Torr程度の真空に保たれる。成長用ガスなどを供給するストに連結されている。

進載板 15は例えばタンタル板で作り、直径 1 mm 程度の穴 15a をあけ、穴 15a の位置はレンズ 12の 魚点位置にくるようにする。遮蔽板 15はチャンバ 19の壁から若干離して配置し、ポート 14内もチャ ンバ内と同程度の真空度に保たれる一方で、基板 16からの再兼発による分子流がファーネス内に入 ることのないようにする。遮蔽板 15は取外し可憶 防止しうる装置を提供することを目的とする。

(問題点を解決するための手段)

第1図は本発明の一実施例の断面図である。

第1図において、レンズ12、ビューボート13を 通ってボート14に入る光11は、レンズ12の焦点位 置に配置された遮蔽板15の穴15aを通って携板16 に照射される構成となっている。

〔作用〕

本発明の目的は、基板にあてる光をさえぎらず、 基板からの再蒸発をさえぎり、ビューポートをく もらないようにすることにあるので、焦点位置に 穴を設けることによって光をさえぎらず、また穴 が小さいので基板から再蒸発した分子はほとんど ビューポートにあたらないようにしたものである。

(実施例)

以下、図面を参照して本発明の実施例を詳細に 説明する。

に設置し、チャンパを清浄するとき共に清浄されるようにするとよい。

前記した構成により、光は穴15a で较られ、しかる後に基板16に照射されるが、基板16の再落発による分子は、穴15a が前記した如く小さいものであるので、ほとんどピューポートに達することがなく、遮蔽板がないときは数枚の基板にエピクキシャル成長した段階でピューポートがくもったが、図示の実施例においては、20枚の基板に結晶成長させてもくもりはほとんど観測されなかった。

第2 図は本発明の他の実施例の断面図で、この実施例においては、遮蔽板 15に代えて遮蔽プロック 25を用いる。プロック 25は中央部にテーパした関孔部 25a が形成されたもので、関孔部 25a のビューボートに近い側で小穴を提供する構成とし、この小穴がレンズ 12の焦点位置にあるようにする。プロックの形状は直方体または円柱体いずれでもよいが、それをチャンパ内に固定すると同様にチャンパの壁との間に僅かの空隙を残すようにする。この実施例では関孔部

特開昭62~42514(3)

25a がつまり難く、遮蔽板よりもより長期の使用が可能である。

(発明の効果)

.

以上述べてきたように本発明によれば、MBE 装置においてビューポートのくもりが抑えられ、半導体装置製造工程の作業性を改善するに有効である。

4. 図面の簡単な説明

第1図と第2図は本発明実施例の断面図、

第3図は従来例断面図である。

第1図と第2図において、

11は光、

12はレンズ、

13はビューポート、

14はポート、

15は遮蔽板、

15a は穴、

16は基板、

17はステージ、

18はヒータ、

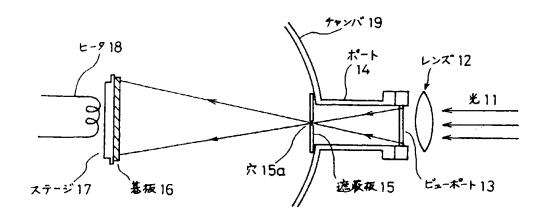
19はチャンバ、

25は遮蔽プロック、

25a は開孔部である。

代理人 弁理士 井 桁 貞





本発明实施例断面图

第1図

